УДК 621.396.67.01

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ МИКРОПОЛОСКОВОЙ АНТЕННЕ

А. Е. Свеженцев

Институт радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАНУ, г. Харьков, Украина

Рассмотрена задача о возбуждении цилиндрических микрополосковых антенн с излучателями сложной формы, которые способны формировать излучение с преимущественно горизонтальной поляризацией. Задача решена методом моментов в спектральной области с использованием кусочнозаданных базисных функций. В качестве излучающих систем рассмотрены прямоугольно-цилиндрический излучатель с согласующим компланарным переходом и две пары связанных рамочных полосковых излучателей с щелями, расположенными в азимутальной плоскости. Излучатели возбуждаются цилиндрической микрополосковой линией, последняя — дельта-генератором. Достигнуто согласование излучающей системы и микрополосковой линии. Показана возможность формирования изотропного в азимутальной плоскости излучения с горизонтальной поляризацией.

ВВЕДЕНИЕ

Множество современных систем связи, в которых используются печатные антенны, требуют расположения печатных излучателей на криволинейной поверхности, в т. ч. цилиндрической. Такие печатные антенны называются цилиндрическими микрополосковыми антеннами. От аналогов они выгодно отличаются малым весом и низкой стоимостью. Цилиндрические микрополосковые антенны изучались различными методами [1–19], особенности применения которых зависят от так называемого волнового размера антенны, определяемого отношением радиуса цилиндра r_1 к длине волны λ . Для изучения антени с малым волновым размером $(r_1/\lambda < 1)$ наиболее подходящим является метод моментов [5–19], который может применяться как в пространственной [5, 10, 11–14, так и в спектральной областях [6–9, 15–19]. В первом случае должна быть вычислена функция Грина в пространственной области, во втором вычисляется только её спектральный эквивалент. Выбор базисных функций в схеме метода моментов зависит от формы излучателя. Если форма излучателя является сложной, то его поверхность разделяется на сегменты и вводятся кусочно-заданные базисные функции, например синусоидальные [10, 15–18] или линейные остроугольные [11–14]. Изучению цилиндрических микрополосковых антенн с излучателями сложной формы посвящены статьи [8, 14–18], в которых они возбуждались цилиндрической микрополосковой линией [8, 14], коаксиальной линией [16] либо плоской волной [15–18]. К основным изученным характеристикам цилиндрических микрополосковых антенн относятся входное сопротивление, диаграммы направленности на резонансных частотах и радиолокационное сечение рассеяния.

Одним из важных вопросов при изучении цилиндрических микрополосковых антенн является формирование с помощью них излучения с заданной преобладающей поляризацией, в частности вертикальной (θ -поляризация) либо горизонтальной (φ -поляризация). Для того, чтобы в дальней зоне получилось поле с θ - либо φ -поляризацией, необходимо возбудить основные колебания z- либо φ -поляризованного излучателя соответственно. К настоящему времени наиболее полно рассматривались цилиндрические микрополосковые антенны как с z-поляризованными, так и φ -поляризованными излучателями прямоугольно-цилиндрической формы. В достаточной мере

изучены и цилиндрические микрополосковые антенные решётки из таких излучателей. При этом оценка уровня кросс-поляризации показала, что меньший уровень последней достигается в случае *z*-поляризованного излучателя, т.е. при возбуждении поля с θ -поляризацией в дальней зоне. Отметим, что в этом случае реально достигнуть изотропной в азимутальной плоскости диаграммы направленности, расположив излучатели в φ -направлении [19]. Также важно отметить, что изучение уровня кросс-поляризации для цилиндрических микрополосковых антенн с излучателями сложной формы фактически не проводилось. Следовательно, этот вопрос является актуальным и требует детального исследования.

Целью данной работы является моделирование цилиндрической микрополосковой антенной решётки, которая обладает двумя полезными свойствами, а именно преобладающей φ -поляризацией излучения и свойством изотропности излучения в горизонтальной, или, что то же самое, азимутальной, плоскости. В статье, во-первых, будут рассмотрены характеристики цилиндрической микрополосковой антенны с излучателем прямоугольно-цилиндрической формы как без согласующего компланарного перехода, так и с ним. Во-вторых, будет рассмотрена цилиндрическая микрополосковая антенная решётка, состоящая из двух пар связанных рамочных полосковых излучателей с щелями. В таком устройстве излучатели бесконтактно возбуждаются цилиндрической микрополосковой линией. Отметим, что указанные излучатели были предложены в [17] и рассмотрены там только для случая θ -поляризации. Для решения поставленной электродинамической задачи будет применяться метод моментов, реализованный в спектральной области [15–18] с использованием кусочно-заданных синусоидальных базисных функций. Будут рассчитаны входное сопротивление антенны, а также распределение тока на излучателях и диаграммы направленности её излучения на резонансной частоте.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ЕЁ РЕШЕНИЕ

Исследуемые модели цилиндрических микрополосковых антенн изображены на рис. 1 и 2. Это, во-первых, цилиндрическая микрополосковая антенна с излучателем прямоугольно-цилиндрической формы, имеющим согласующий компланарный переход (рис. 1) и цилиндрическая микрополосковая антенная решётка с двумя парами связанных рамочных полосковых излучателей (рис. 2). В обоих случаях излучатели возбуждаются с помощью цилиндрической микрополосковой линии. Обе антенны базируются на линии Губо [20] (см. рис. 1 и 2), образованной бесконечным в направлении оси z металлическим цилиндром с радиусом $r = r_1$, на котором расположен круговой диэлектрический слой с внешним радиусом $r = r_0$. Относительная диэлектрическая проницаемость слоя ε_r . На поверхности линии Губо размещены цилиндрическая микрополосковая линия и металлические излучатели сложной формы. Формы традиционного прямоугольно-цилиндрического излучателя, излучателя с компланарным согласующим переходом, а также рамочного полоскового излучателя с щелью показаны на рис. За-6 соответственно. Здесь, как и в [5–18], задача сводится к решению интегрального уравнения, вытекающего из равенства нулю полного тангенциального электрического поля на металлической поверхности излучателя при $r = r_0$. Полное поле представляется в виде суммы двух полей: поля $E_s^{\text{scat},\text{J}}(r,\varphi,z)$, порождаемого током на излучателе, и поля возбуждения $E_s^{p,\text{exc}}(r,\varphi,z)$. В итоге на поверхности излучателя при $r = r_0$ имеем

$$E_s^{\text{scat,J}}(r,\varphi,z) + E_s^{p,\text{exc}}(r,\varphi,z) = 0, \qquad (1)$$

где

768

$$\begin{pmatrix} E_z^{\text{scat},J}(r,\varphi,z) \\ E_\varphi^{\text{scat},J}(r,\varphi,z) \end{pmatrix} = \iint_{z'\varphi'} \hat{\mathbf{G}}^J(r,r_0,z,z',\varphi,\varphi') \begin{pmatrix} J_z^e(r_0,\varphi',z') \\ J_\varphi^e(r_0,\varphi',z') \end{pmatrix} \mathrm{d}S',$$
(2)



Рис. 1. Цилиндрическая микрополосковая антенна с излучателем прямоугольно-цилиндрической формы с согласующим компланарным переходом, возбуждаемая микрополосковой линией: 1 — металл, 2 — излучатель, 3 — микрополосковая линия, 4 — дельта-генератор



Рис. 2. Цилиндрическая микрополосковая антенна решётка с двумя парами связанных рамочных полосковых излучателей со щелями, возбуждаемая микрополосковой линией: 1 — металл, 2 излучатель, 3 — микрополосковая линия, 4 дельта-генератор



Рис. 3. Формы излучателей цилиндрической микрополосковой антенны: (a) — излучатель прямоугольно-цилиндрической формы, (b) — прямоугольно-цилиндрический излучатель с согласующим компланарным переходом, (b) — рамочный полосковый излучатель с щелью

$$\hat{\mathbf{G}}^{J}(r,r_{0},z,z',\varphi,\varphi') = \begin{pmatrix} G_{zz}^{J}(r,r_{0},z,z',\varphi,\varphi') & G_{z\varphi}^{J}(r,r_{0},z,z',\varphi,\varphi') \\ G_{\varphi z}^{J}(r,r_{0},z,z',\varphi,\varphi') & G_{\varphi \varphi}^{J}(r,r_{0},z,z',\varphi,\varphi') \end{pmatrix},$$
(3)

 $s = (z, \varphi), \hat{\mathbf{G}}^J - функция Грина, J_s^e -$ неизвестная плотность эквивалентного поверхностного тока, индекс p обозначает принадлежность к одной из двух частичных областей: p = 0 соответствует области $r > r_0$, а p = 1 – области $r_0 > r > r_1$. Вывод выражения (2) приведён в статье [6]. Схема введения кусочно-заданных синусоидальных базисных функций и реализация метода моментов в спектральной области детально рассмотрены в работе [15]. В результате задача сводится к решению системы линейных алгебраических уравнений:

$$\mathbf{Z}\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{V},\tag{4}$$

Том LIV, № 10

где $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_N)^{\mathrm{T}}$ — столбец неизвестных комплексных амплитуд базисных функций, \mathbf{Z} — матрица взаимных импедансов [15], $\mathbf{V} = (V_1, V_2, V_3, \dots, V_N)^{\mathrm{T}}$ — вектор-столбец правой части, элементы которого в случае возбуждения дельта-генератором имеют вид [21]:

$$V_i = \begin{cases} -1 \text{ B}, & z = z_g; \\ 0, & z \neq z_g. \end{cases}$$
(5)

В результате решения системы (4) находятся распределение тока на излучателях и микрополосковой линии, а также поле в дальней зоне. Следующим шагом является нахождение коэффициента отражения в микрополосковой линии с помощью теории передающих линий и метода эквивалентных схем [14, 21].

2. ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2.1. Цилиндрическая микрополосковая антенна с *φ*-поляризованным прямоугольно-цилиндрическим излучателем



Рис. 4. Зависимости модуля коэффициента отражения $|\rho|$ от частоты f для цилиндрической микрополосковой антенны с излучателями двух типов: кривая 1 соответствует прямоугольно-цилиндрическому излучателю, 2 — прямоугольно-цилиндрическому излучателю с согласующим компланарным переходом

Вначале обратимся к цилиндрической микрополосковой антенне с прямоугольно-цилиндрическим излучателем (рис. 1), имеющим согласующий переход (рис. 36). Благодаря симметричной запитке излучатель является φ -поляризованным и в нём возбуждается соответствующая основная мода [15, 18]. Пусть цилиндрическая микрополосковая антенна имеет такие же параметры, как и в статье [4], а именно $W_z = 3$ см, $W_{\varphi} = 4$ см, $r_1 =$ = 5 см, ε_r = 2,32, r_0/r_1 = 1,0159. Отметим, что в [4] рассмотрен φ -поляризованный излучатель прямоугольно-цилиндрической формы при возбуждении штырём. Здесь же, в отличие от [4], излучатель возбуждается с помощью цилиндрической микрополосковой линии, один отрезок которой с длиной $L_{1str} = 19,035$ см расположен вдоль оси z, а другой отрезок с длиной $L_{2\rm str}=9,87~{
m cm}$ развёрнут на 90° и расположен в φ -направлении так, что он примыкает к середине излучателя.

Также отметим, что для согласования микрополосковой линии и излучателя применён так называемый согласующий переход на компланарную линию. Ширина микрополосковой линии $W_{\rm str} = 0.235$ см. Излучатель разбит на 13 × 17 сегментов в z- и φ -направлениях соответственно. Размеры выемки на излучателе $W_1 = 0.705$ см и $W_2 = 1.41$ см. На рис. 4 изображены зависимости модулей коэффициентов отражения для цилиндрической микрополосковой антенны с излучателя, а кривая 2 — излучателю с согласующим компланарным переходом. Видно, что для прямоугольноцилиндрического излучателя согласование плохое, поскольку коэффициент $|\rho|$ равен 0.86 в слабо выраженном минимуме на частоте f = 2.45 ГГц. Отметим, что согласно результатам статьи [4], где вычислялось входное сопротивление цилиндрической микрополосковой антенны при её возбуждении коаксиальной линией, резонансная частота при возбуждении основной моды для

 φ -поляризованного излучателя равна 2,449 ГГц. Сравнение этих резонансных частот говорит об их хорошем совпадении. Результаты расчёта для излучателя с согласующим переходом (кривая 2) показывают, что в этом случае согласование линии и излучателя значительно лучше, поскольку коэффициент $|\rho|$ принимает минимальное значение 0,18 на резонансной частоте f == 2,5 ГГц, что соответствует обратным потерям $S_{11} = -14,89$ дБ. Положительный сдвиг резонансной частоты на 2 % для излучателя с согласующим переходом по отношению к излучателю прямоугольно-цилиндрической формы объясняется уменьшением площади металлического излучателя.

Распределение модуля φ -компоненты плотности тока на излучателе показано на рис. 5. Из него видно, что вариация амплитуды плотности тока в микрополосковой линии по сравнению с её средним значением невелика, что говорит о близости падающей волны к бегущей волне, т.е. о



Рис. 6. Диаграммы направленности излучения цилиндрической микрополосковой антенны с прямоугольно-цилиндрическим излучателем, имеющим согласующий компланарный переход на резонансной частоте $f = 2,5 \Gamma \Gamma$ ц: (a) — зависимости модулей компонент E_{φ} и E_{θ} от угла φ при $\theta = 90^{\circ}$; (δ) — зависимости модулей компонент E_{φ} и E_{θ} от угла θ при $\varphi = 42^{\circ}$; (a) — зависимость модулей компонент E_{φ} и E_{θ} от угла θ при $\varphi = 0^{\circ}$. Кривая 1 соответствует основной поляризации (модуль компоненты E_{φ}), 2 — кросс-поляризации (модуль компоненты E_{θ})



Рис. 5. Распределение модуля φ -компоненты электрического тока, вычисленное на резонансной частоте f = 2,5 ГГц, на прямоугольно-цилиндрическом излучателе с согласующим компланарным переходом и на питающей цилиндрической микрополосковой линии



А. Е. Свеженцев

режиме согласования. На рис. 6 представлены диаграммы направленности антенны, изображённой на рис. 1, на резонансной частоте f = 2,5 ГГц в виде зависимостей модулей компонент поля E_{φ} и E_{θ} от угла φ при $\theta = 90^{\circ}$ (см. рис. 6a) и от угла θ при $\varphi = 42^{\circ}$ и $\varphi = 0^{\circ}$ (см. рис. 66 и eсоответственно). Система координат введена таким образом, что полуплоскость $\varphi = 42^{\circ}$ проходит примерно через середину излучателя, а полуплоскость $\varphi = -79^{\circ}$ — примерно через расположенный в z-направлении отрезок цилиндрической микрополосковой линии. Из рис. 6a видно, что пирина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости по уровню 0,7 примерно равна 90°, а при $\theta = 90^{\circ}$ уровень кросс-поляризации не превышает -30 дБ. Сравнение результатов, представленных на рис. 6a и δ показывает, что в случаях $\varphi = 42^{\circ}$ (см. рис. 66) и $\varphi = 0^{\circ}$ (см. рис. 6e) максимальные уровни кросс-поляризации составляют -22 дБ и -10 дБ соответственно. Расчёты показали, что при $\varphi = -79^{\circ}$ уровень кросс-поляризации составляют -6 дБ. Это объясняется тем, что в этом случае вклад в излучение z-компоненты тока в питающей линии проявляется сильнее, чем в предыдущих случаях.

2.2. Цилиндрическая микрополосковая антенная решётка с *φ*-поляризованными рамочными полосковыми излучателями с щелями

Обратимся к структуре, изображённой на рис. 2. В ней на поверхности линии Губо расположены два излучающих элемента, каждый из которых состоит из пары связанных рамочных полосковых излучателей, расположенных по обе стороны от цилиндрической микрополосковой линии с шириной проводника $W_{\rm str} = 0,229$ см. В свою очередь, цилиндрическая микрополосковая линия устроена таким образом, что одна её часть с длиной $L_{1str} = 28,167$ см расположена вдоль z-направления, а другая часть с длиной $L_{2str} = 30,746$ см развёрнута на угол 90° и образует незамкнутое кольцо в азимутальной плоскости. Именно в этой части линии и находятся излучающие элементы. Последние расположены таким образом, что расстояние между ними вдоль дуги окружности равно половине длины окружности с радиусом $r = r_0$. Каждый рамочный полосковый излучатель с щелью (см. рис. 3*6*) размещён на сетке с 8 × 16 сегментами в *z*- и *φ*направлениях соответственно. Параметры цилиндрической микрополосковой антенной решётки таковы, что $r_1 = 0,05$ м, $\varepsilon_{\rm r} = 2,2, r_0/r_1 = 1,0159, W_z = 1,832$ см, $W_{\varphi} = 3,664$ см, $L_z = L_{\varphi} = 1,0159, W_z = 1,0159, W_z = 1,0159$ = 0.458 см, $L_s = 0.916$ см. Зазор между излучателем и микрополосковой линией равен 2,29 мм. На рис. 7а представлена зависимость модуля коэффициента отражения в микрополосковой линии от частоты. Из хода кривой видно, что на резонансной частоте f=1,365 ГГц коэффициент отражения достигает минимального значения 0,05, что соответствует уровню величины обратных потерь $S_{11} = -25,85$ дБ. Распределение модуля φ -компоненты тока на излучателях и примыкающему к ним отрезке цилиндрической микрополосковой линии на резонансной частоте представлено на рис. 76.

Изучение амплитудных и фазовых распределений φ - и z-компонент тока показало, что в системе из двух связанных излучателей φ -компоненты тока являются синфазными и имеют максимальное значение на сторонах, расположенных напротив щелей, а z-компоненты на боковых стенках излучателей являются противофазными. Важно отметить, что φ -компоненты тока являются синфазными на двух излучающих элементах. Объясняется это тем, что расстояние между центрами излучающих элементов 16,06 см, что близко к значению длины волны $\lambda_{\rm g} = 15,81$ см в отрезке микрополосковой линии. На рис. 8 представлены рассчитанные на резонансной частоте диаграммы направленности излучения исследуемой цилиндрической микрополосковой антенной решётки в виде зависимостей модулей компонент E_{φ} и E_{θ} от угла φ при $\theta = 90^{\circ}$ (см. рис. 8*a*) и от угла θ при $\varphi = 114^{\circ}$ и $\varphi = 0^{\circ}$ (см. рис. 8*b* и *b* соответственно). Из рис. 8*a* видно, что диаграмма направленности в горизонтальной плоскости близка к изотропной, и максимальные отклонения



Рис. 7. Зависимость модуля коэффициента отражения от частоты для цилиндрической микрополосковой антенной решётки с двумя парами связанных рамочных полосковых излучателей с щелями (a) и распределение модуля φ -компоненты электрического тока, вычисленное на резонансной частоте f = 1,365 ГГц на излучателях цилиндрической микрополосковой антенной решётки и на питающей цилиндрической микрополосковой линии (δ)



Рис. 8. Диаграммы направленности излучения цилиндрической микрополосковой антенной решётки с двумя парами связанных рамочных полосковых излучателей с щелями, рассчитанные на резонансной частоте $f = 1,365 \ \Gamma \Gamma_{II}$: (a) – зависимость модуля компоненты E_{φ} от угла φ при $\theta = 90^{\circ}$; (b) – зависимость модуля компоненты E_{φ} от угла θ при $\varphi = 114^{\circ}$; (b) – зависимость модуля компоненты E_{φ} от угла θ при $\varphi = 0^{\circ}$. Кривая 1 соответствует основной поляризации (модуль компоненты E_{φ}), 2 – кросс-поляризации (модуль компоненты E_{θ})



А. Е. Свеженцев

773

от неё лежат в пределах -2,5 дБ. В этом случае уровень кросс-поляризации не превышает -30 дБ. На рис. 86 диаграмма направленности в виде зависимости модуля компоненты E_{φ} от угла θ построена в плоскости $\varphi = 114^{\circ}$, проходящей через середину одного из излучателей. В этом случае уровень кросс-поляризации не превышает -20 дБ. Отметим, что в других плоскостях $\varphi = \text{const}$ уровень кросс-поляризации может заметно повышаться. В частности, в плоскости $\varphi = 0^{\circ}$, проходящей примерно между двумя излучающими элементами, уровень кросс-поляризации максимален и не превышает -12,5 дБ во всём диапазоне изменения угла θ , как это следует из рис. 86. Учитывая, что в данном случае (см. рис. 2) ось *z* цилиндрической микрополосковой антенной решётки расположена в вертикальном направлении и $\theta = 90^{\circ}$ соответствует направлению, параллельному земной поверхности, отметим тот факт, что в диапазоне углов места $75^{\circ} < \theta < 90^{\circ}$ уровень кросс-поляризации не превышает -18,8 дБ. Важно также подчеркнуть, что резонансная частота φ -поляризации не превышает -18,8 дБ. Важно также подчеркнуть, что резонансная частота $\psi_{\varphi} = 3,664$ см, которые аналогичны внешним размерам рассмотренного рамочного полоскового излучателя, принимает значение 2,75 ГГц, что существенно выше значения f = 1,365 ГГц, полученного для рамочного полоскового излучателя.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в статье рассмотрена задача о формировании излучения горизонтальной поляризации цилиндрической микрополосковой антенной с излучателями сложной формы при её возбуждении цилиндрической микрополосковой линией. Решение данной задачи получено методом моментов в спектральной области с применением кусочно-заданных синусоидальных базисных функций. В качестве излучателей сложной формы рассмотрены, во-первых, φ -поляризованный прямоугольно-цилиндрический излучатель как с согласующим компланарным переходом, так и без него, во-вторых, расположенные в азимутальной плоскости две пары рамочных полосковых излучателей с щелями. Получено хорошее совпадение резонансной частоты основной φ поляризованной моды цилиндрической микрополосковой антенны, возбуждаемой линией с прямоугольно-цилиндрическим излучателем, с имеющимися в литературе результатами для резонансной частоты аналогичной цилиндрической микрополосковой антенны при её возбуждении штырём.

Показано, что рассмотренная цилиндрическая микрополосковая антенная решётка с рамочными полосковыми излучателями обладает рядом интересных и полезных свойств. Во-первых, рамочные полосковые излучатели не имеют непосредственного электрического контакта с возбуждающей их цилиндрической микрополосковой линией. Связь излучателей и линии можно регулировать, например, путём изменения расстояния между ними. Во-вторых, у данной цилиндрической микрополосковой антенной решётки электрическое поле в дальней зоне является в основном горизонтально поляризованным, т. е. обладающим в основном φ -поляризацией, с невысоким уровнем кросс-поляризации, а диаграмма направленности близка к изотропной. В-третьих, рассмотрено применение в цилиндрических микрополосковых антенных решётках рамочных полосковых излучателей, резонансная частота которых лежит в существенно более низкочастотной области, чем резонансная частота прямоугольно-цилиндрического излучателя.

Автор выражает глубокую благодарность В. В. Крыжановскому, безвременно ушедшему в расцвете творческих сил, за плодотворные дискуссии, впоследствии послужившие толчком к написанию данной статьи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Выражения для расчёта функции Грина в спектральной области

Компоненты функции Грина в спектральной области $\hat{G}^J(n,h)$ имеют вид

$$\hat{G}^{J}(n,h) = \begin{pmatrix} \chi_{nzz}(\bar{h}) \ \chi_{nz\varphi}(\bar{h}) \\ \chi_{n\varphi z}(\bar{h}) \ \chi_{n\varphi\varphi}(\bar{h}) \end{pmatrix},$$

$$\chi_{nzz}(\bar{h}) = -\frac{\Delta_n^H(\bar{h})}{\Delta_n(\bar{h})} \frac{w_0}{k_0 r_0}, \qquad \chi_{nz\varphi}(\bar{h}) = \chi_{n\varphi z}(\bar{h}) = iw_0 \bar{F}_n \frac{\bar{\Delta}_n(\bar{h})}{\Delta_n(\bar{h})} + \frac{n\bar{h}w_0}{x_1^2} \frac{\Delta_n^H(\bar{h})}{\Delta_n(\bar{h})}; \qquad (\Pi 1.1)$$

$$\begin{split} \chi_{n\varphi\varphi}(\bar{h}) &= -\frac{iw_0 n\bar{h}k_0 r_0}{x_0 x_1} \frac{\bar{\Delta}_n(\bar{h})}{\Delta_n(\bar{h})} \left[\frac{x_0}{x_1} \,\bar{F}_n(\bar{h}) + \frac{x_1}{x_0} \,\Phi_n(\bar{h}) \right] - \\ &- \frac{(n\bar{h})^2 \,w_0 k_0 r_0}{(x_0 x_1)^2} \frac{\Delta_0^H(\bar{h})}{\Delta_n(\bar{h})} + k_0 r_0 w_0 \Phi_n(\bar{h}) \bar{F}_n \,\frac{\Delta_n^E(\bar{h})}{\Delta_n(\bar{h})} \,, \end{split}$$

где

$$\begin{split} \bar{\Delta}_{n}(\bar{h}) &= n\bar{h} \left(x_{1}^{-2} - x_{0}^{-2} \right), \qquad \Delta_{n}^{E}(\bar{h}) = -i \left[\Phi_{n}(\bar{h}) - \varepsilon_{r1}F_{n}(\bar{h}) \right], \\ \Delta_{n}^{H}(\bar{h}) &= i \left[\Phi_{n}(\bar{h}) - \bar{F}_{n}(\bar{h}) \right], \qquad F_{n}(\bar{h}) = \frac{\gamma_{1}'(r_{0})}{x_{1}\gamma_{1}(r_{0})}, \qquad \bar{F}_{n}(\bar{h}) = \frac{\bar{\gamma}_{1}'(r_{0})}{x_{1}\bar{\gamma}_{1}(r_{0})}, \\ \Phi_{n}(\bar{h}) &= \frac{\gamma_{0}'(r_{0})}{x_{0}\gamma_{0}(r_{0})}, \qquad \Delta_{n}(\bar{h}) = \bar{\Delta}_{n}(\bar{h}) - \Delta_{n}^{E}(\bar{h})\Delta_{n}^{H}(\bar{h}), \qquad \gamma_{n0}(r,\bar{h}) = \frac{H_{n}^{(2)}(\tilde{k}_{0}r)}{H_{n}^{(2)}(\tilde{k}_{0}r_{0})}, \\ \gamma_{n1}(r,h) &= \frac{H_{n}^{(2)}(\tilde{k}_{1}r_{1})}{H_{n}^{(2)}(\tilde{k}_{1}r_{1})} + \Gamma_{1}\frac{J_{n}(\tilde{k}_{1}r)}{J_{n}(\tilde{k}_{1}r_{1})}, \qquad \bar{\gamma}_{n1}(r,\bar{h}) = \frac{H_{n}^{(2)}(\tilde{k}_{1}r)}{H_{n}^{(2)}(\tilde{k}_{1}r_{1})} + \bar{\Gamma}_{1}\frac{J_{n}(\tilde{k}_{1}r)}{J_{n}(\tilde{k}_{1}r_{1})}, \\ \Gamma_{1} &= -\frac{J_{n}(\bar{x}_{1})}{J_{n}(x_{1})}\frac{H_{n}^{(2)}(x_{1})}{H_{n}^{(2)}(\bar{x}_{1})}, \qquad \bar{\Gamma}_{1} = -\frac{J_{n}'(\bar{x}_{1})}{J_{n}(x_{1})}\frac{H_{n}^{(2)}(x_{1})}{H_{n}'^{(2)}(\bar{x}_{1})}, \\ \bar{k}_{i}^{2} &= k_{0}^{2}\left(\varepsilon_{ri} - \bar{h}^{2}\right), \qquad x_{i}^{2} = (k_{0}r_{0})^{2}\left(\varepsilon_{ri} - \bar{h}^{2}\right), \qquad \bar{x}_{1}^{2} = (k_{0}r_{1})^{2}\left(\varepsilon_{r1} - \bar{h}^{2}\right), \end{split}$$

где $J_n(x)$ — функция Бесселя, $H_n^{(2)}(x)$ — функция Ганкеля второго рода, ε_{ri} — относительная диэлектрическая проницаемость.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Задание базисных функций

В предложенной в данной работе схеме Галёркина в качестве базисных функций использованы кусочно-заданные синусоидальные функции [22]. Плотность тока для z- и φ -ориентированных таких базисных функций с центрами в точках (z_i^b, φ_i^b) и (z_k^b, φ_k^b) соответственно имеет вид

$$\mathbf{J}_{iz}^{b}(z) = J_{iz}^{b}(z)\mathbf{z}^{0} = \frac{\sin[p_{z}\left(\Delta_{z} - |z - z_{i}^{b}|\right)]}{\sin(p_{z}\Delta_{z})}\,\mathbf{z}_{0},\tag{\Pi2.1}$$

$$\mathbf{J}_{k\varphi}^{b}(\varphi) = J_{k\varphi}^{b}(\varphi)\boldsymbol{\varphi}^{0} = \frac{\sin[p_{\varphi}\left(\Delta_{\varphi} - |\varphi - \varphi_{k}^{b}|\right)]}{\sin(p_{\varphi}\Delta_{\varphi})}\boldsymbol{\varphi}_{0},\tag{\Pi2.2}$$

где \mathbf{z}^0 и $\boldsymbol{\varphi}^0$ — орты в *z*- и φ -направлениях, $p_z = k_0 p_0$, $p_{\varphi} = k_0 r_0 p_z$, $p_0 = \sqrt{(\varepsilon_r + 1)/2}$. Фурьепреобразование для *z*-ориентированных кусочно-заданных базисных функций можно представить как

$$\tilde{\mathbf{J}}_{zi}^{b(t)}(r_0, n, h) = \tilde{J}_{zi}^{b(t)}(r_0, n, h)\mathbf{z}_0 = \exp(iz_i^{(b,t)}h)\exp(in\varphi_i^{(b,t)})a_z^n(n)a_z^h(h)\mathbf{z}_0, \tag{II2.3}$$

где

$$a_{z}^{h}(\bar{h}) = \frac{4}{A_{z}} \sin[\Delta_{z} (h + p_{z})/2] \sin[\Delta_{z} (h - p_{z})/2] \frac{p_{z}}{h^{2} - p_{z}^{2}},$$
$$a_{z}^{n}(n) = 2 \sin[\Delta_{\varphi} n/2]/n, \qquad A_{z} = \sin(p_{z}\Delta_{z}),$$

а для φ -ориентированных кусочно-заданных синус
оидальных базисных функций как

$$\tilde{\mathbf{J}}_{\varphi k}^{b(t)}(r_0, n, h) = \tilde{J}_{\varphi k}^{b(t)}(r_0, n, h)\boldsymbol{\varphi}_0 = \exp(iz_k^{(b,t)}h)\exp(in\varphi_k^{(b,t)})a_{\varphi}^n(n)a_{\varphi}^h(h)\boldsymbol{\varphi}_0, \tag{II2.5}$$

где

$$a_{\varphi}^{n}(n) = \frac{4}{A_{\varphi}} \sin[\Delta_{\varphi} (n+p_{\varphi})/2] \sin[\Delta_{\varphi} (n-p_{z})/2] \frac{p_{\varphi}}{n^{2}-p_{\varphi}^{2}},$$
$$a_{\varphi}^{h}(n) = 2 \sin[\Delta_{\varphi} h/2]/h, \qquad A_{\varphi} = \sin(p_{\varphi} \Delta_{\varphi}).$$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Proc. 5th European Workshop on Conformal Antennas, September 10–11, Bristol, United Kingdom, 2007.
- 2. Proc. 6th European Conference on Antennas and Propagation, 23–27 March, Berlin, Germany, 2009.
- Wu K.-Y., Kaufman J. F. // Digest IEEE Anten. Propagat. Soc. Int. Symp. New York: IEEE, 1983. P. 39.
- 4. Luk K.-M., Lee K.-F., Dahele J.S. // IEEE Trans. Anten. Propagat. 1989. V. 37, No. 2. P. 143.
- Silva F. C., Fonseca S. B. A., Soares A. J. M., Giarola A. J. // IEEE Trans. Anten. Propagat. 1991. V. 39, No. 9. P. 1 398.
- 6. Habashy T. M., Ali S. M., Kong J. A. // IEEE Trans. Anten. Propagat. 1990. V. 38, No. 6. P. 722.
- Vecchi G., Bertuch T., Orefice M. // Proc. Int. Conf. on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA96), Torino, 1996. P. 301.
- Bertuch T., Vecchi G., Orefice M. // Proc. Millennium Conf. Anten. Propag., Davos, Switzerland, 2000.
- 9. Raffaelli S., Sipus Z., Kildal P.-S. // IEEE Trans. Anten. Propagat. 2005. V. 53, No. 3. P. 1105.
- 10. Erturk V. B., Rojas R. G. // IEEE Trans. Anten. Propagat. 2003. V. 51, No. 4. P. 739.
- 11. Свеженцев А. Е. // Изв. вузов. Радиофизика. 2005. Т. 48, № 6. С. 523.
- Svezhentsev A. Ye., Vandenbosch G. A. E. // IEE Proc. Microwaves, Anten. Propagat. 2006. V. 153, No. 4. P. 376.
- 13. Свеженцев А. Е. // Изв. вузов. Радиофизика. 2007. Т. 50, № 2. С. 134.
- 14. Свеженцев А. Е. // Изв. вузов. Радиофизика. 2008. Т. 51, № 3. С. 223.
- 15. Svezhentsev A. Ye., Kryzhanovskiy V. V. // Prog. Electromag. Res. (PIERB). 2009. No. 15. P. 307.
- Svezhentsev A. Ye. // Proc. 3rd European Conf. Anten. Propagat. (Eucap), 23–29 March 2009, Berlin, Germany. P. 2477.

- 17. Свеженцев А. Е., Крыжановский В. В. // Радиофизика и электроника. 2010. Т. 15, № 1. С. 30.
- 18. Свеженцев А. Е., Крыжановский В. В. // Радиотехника и электроника. 2011. Т. 56, № 7. С. 1.
- Loffer D., Rostan F., Wiesbeck W. // Digest IEEE Anten. Propagat. Soc. Int. Symp. Montreal: IEEE, 1997. V. 3. P. 1533.
- 20. Goubau G. // J. Appl. Phys. 1950. V. 21, No. 11. P. 1119.
- 21. Davidovitz M., Lo Y. T. // IEEE Trans. Anten. Propagat. 1989. V. 37, No 8, P. 949.
- 22. Pozar D. M. // IEEE Trans. Anten. Propagat. 1982. V. 30, No. 11. P. 1191.

Поступила в редакцию 29 июня 2011 г.; принята в печать 26 октября 2011 г.

FORMATION OF HORIZONTALLY POLARIZED RADIATION IN A CYLINDRICAL MICROSTRIP ANTENNA

A. E. Svezhentsev

We consider the problem of excitation of cylindrical microstrip antennas with complex-shaped radiators, which are capable of producing radiation mainly with horizontal polarization. The problem is solved by the method of moments in the spectral region by using the piecewise-specified basic functions. The radiating systems under consideration are a rectangular-cylindrical radiator with a matching coplanar transition and two pairs of coupled loop strip radiators with slots located in the azimuthal plane. The radiators are excited by a cylindrical microstrip line, and the line, with a delta generator. Coupling of the radiating system and the microstrip line is achieved. The possibility to produce the horizontally polarized radiation, which is isotropic in the azimuthal plane, is demonstrated.